

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 2001115029	A	20010424	JP 200051137	A	20000228	200345 B

Priority Applications (No Type Date): JP 99228498 A 19990812

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 2001115029	A	7	C08L-083/04	

Abstract (Basic): JP 2001115029 A

NOVELTY - The silica-based film forming coating fluid contains an organic solvent solution containing a basic hydrolytic condensation product of a polyalkoxysilane compound. The polyalkoxysilane compound comprises a tetraalkoxysilane and an alkyltrialkoxysilane in an amount of 5-25 weight% (wt.%) with respect to silica reduced concentration.

USE - For forming silica-based films used as flattening films and interlayer insulating films used in production of semiconductor elements.

ADVANTAGE - The coating liquid has low dielectric constant.

pp: 7 DwgNo 0/1

Title Terms: COATING; FLUID; FORMING; SILICA; BASED; FILM; INSULATE; FILM; CONTAIN; ORGANIC; SOLVENT; SOLUTION; CONTAIN; BASIC; HYDROLYSIS; CONDENSATION; PRODUCT; COMPOUND; COMPRISE

Derwent Class: A26; A85; L03; U11

International Patent Class (Main): C08L-083/04

International Patent Class (Additional): C08G-077/06; C09D-183/04; H01L-021/312; H01L-021/316

File Segment: CPI; EPI

1/5/2

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

013719950

WPI Acc No: 2001-204180/200121

XRAM Acc No: C01-060766

XRPX Acc No: N01-145851

Composition for film formation for production of semiconductors, comprises a product of hydrolysis and condensation obtained by hydrolyzing and condensing organosilicon compound(s)

Patent Assignee: JSR CORP (JAPS)

Inventor: EBISAWA M; HAKAMATSUKA S; INOUE Y; KAKUTA M; NISHIKAWA M; TAMAKI K; YAMADA K

Number of Countries: 028 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 1058274	A1	20001206	EP 2000111678	A	20000531	200121 B
JP 2000345041	A	20001212	JP 99158674	A	19990604	200121
JP 2001164113	A	20010619	JP 99352862	A	19991213	200140
KR 2001049482	A	20010615	KR 200030567	A	20000603	200171
US 6376634	B1	20020423	US 2000585275	A	20000602	200232

Priority Applications (No Type Date): JP 99352862 A 19991213; JP 99158674 A 19990604

Patent Details:

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-115029

(P 2001-115029 A)

(43) 公開日 平成13年4月24日 (2001.4.24)

(51) Int. Cl.	識別記号	F I	マーク(参考)
C08L 83/04		C08L 83/04	4J002
C08G 77/06		C08G 77/06	4J035
C09D183/04		C09D183/04	4J038
H01L 21/312 21/316		H01L 21/312 21/316	C 5F058 G

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全7頁)

(21) 出願番号	特願2000-51137 (P 2000-51137)
(22) 出願日	平成12年2月28日 (2000.2.28)
(31) 優先権主張番号	特願平11-228498
(32) 優先日	平成11年8月12日 (1999.8.12)
(33) 優先権主張国	日本 (JP)

(71) 出願人	000004178 ジェイエスアール株式会社 東京都中央区築地2丁目11番24号
(72) 発明者	林 英治 東京都中央区築地2丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内
(72) 発明者	長谷川 公一 東京都中央区築地2丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内
(72) 発明者	徐 榮秀 東京都中央区築地2丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】シリカ系被膜形成用塗布液およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 半導体素子の製造において使用される平坦化膜や層間絶縁膜などとして有用な比誘電率の低いシリカ系被膜形成用塗布液及びこのものを効率よく製造する方法を得る。

【解決手段】 テトラアルコキシシランとアルキルトリアルコキシシランとからなるポリアルコキシシラン化合物の塩基性加水分解縮合生成物を、SiO₂換算濃度5～25重量%の割合で含有する有機溶剤溶液からなるシリカ系被膜形成用塗布液。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 テトラアルコキシシランとアルキルトリアルコキシシランとからなるポリアルコキシシラン化合物の塩基性加水分解縮合生成物を、SiO₂換算濃度5～25重量%の割合で含有する有機溶剤溶液からなるシリカ系被膜形成用塗布液。

【請求項2】 完全加水分解縮合物に換算した場合、テトラアルコキシシラン5～75重量%およびアルキルトリアルコキシシラン25～95重量%の割合(テトラアルコキシシランおよびアルキルトリアルコキシシランの合計100重量%)であることを特徴とする請求項1記載のシリカ系被膜形成用塗布液。

【請求項3】 テトラアルコキシシランが有するアルコキシル基の炭素数がアルキルトリアルコキシシランが有するアルコキシル基の炭素数よりも大きいことを特徴とする請求項1記載のシリカ系被膜形成用塗布液。

【請求項4】 塩基性触媒がアンモニア水又は有機アミンである請求項1記載のシリカ系被膜形成用塗布液。

【請求項5】 テトラアルコキシシランとアルキルトリアルコキシシランとからなるポリアルコキシシラン化合物を第一有機溶剤に溶解して、SiO₂換算濃度1～5重量%の溶液を調製し、次いでこれを塩基性触媒の存在下加水分解縮合させたのち、第二有機溶剤により置換し、SiO₂換算濃度5～25重量%に調整することを特徴とするシリカ系被膜形成用塗布液の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、半導体素子の製造において使用される平坦化膜や層間絶縁膜などとして有用な比誘電率の低いシリカ系被膜形成用塗布液及びこのものを効率よく製造する方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、半導体素子の製造において使用される平坦化膜や層間絶縁膜には、通常シリカ系被膜が用いられている。そして、このような用途に用いられるシリカ系被膜を形成させる方法としては、塗布法などが知られている。塗布法に用いられるSOG材料として、比較的比誘電率の低いジメチルアルコキシシランの加水分解縮合物やメチルシルセスキオキサンのようなメチルボリシロキサンや水素シルセスキオキサンが提案されているが、このような材料では、まだ比誘電率が高く、十分に満足しうるものとはいえない。低比誘電率の材料としては、アンモニアの存在下にアルコキシシランを縮合して得られる微粒子とアルコキシシランの塩基性部分加水分解物との混合物からなる組成物(特開平5-263045、同5-315319)やポリアルコキシシランの塩基性加水分解物をアンモニアの存在下縮合することにより得られた塗布液(特開平11-340219、同1-340220)が提案されているが、これらの方法で得られる材料はいずれも塗膜均一性が充分ではなかつ

た。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、半導体素子の製造において使用される平坦化膜や層間絶縁膜などとして有用な比誘電率が低く、塗膜均一性に優れたシリカ系被膜形成用塗布液、及びそれを効率よく製造する方法を提供することを目的としてなされたものである。

【0004】

【課題を解決するための手段】 本発明は、テトラアルコキシシランとアルキルトリアルコキシシランとからなるポリアルコキシシラン化合物の塩基性加水分解縮合生成物を、SiO₂換算濃度5～25重量%の割合で含有する有機溶剤溶液からなるシリカ系被膜形成用塗布液ならびにテトラアルコキシシランとアルキルトリアルコキシシランとからなるポリアルコキシシラン化合物を第一有機溶剤に溶解して、SiO₂換算濃度1～5重量%の溶液を調製し、次いでこれを塩基性触媒の存在下加水分解縮合させたのち、第二有機溶剤により置換し、SiO₂換算濃度5～25重量%に調整することを特徴とするシリカ系被膜形成用塗布液の製造方法を提供するものである。

【0005】

【発明の実施の形態】 本発明において用いられるポリアルコキシシラン化合物とは、ケイ素原子に結合したアルコキシル基を少なくとも2個有するシラン化合物のことである。本発明では、ポリアルコキシシラン化合物としてテトラアルコキシシランおよびアルキルトリアルコキシシランの2種を使用することが必要である。本発明においてテトラアルコキシシランとしてはテトラメトキシシラン、テラエトキシシラン、テラブロポキシシラン、テラブロキシシラン、好ましくはテトラメトキシシラン、テラエトキシシランなどのテトラ低級アルコキシシランを挙げることができ、アルキルトリアルコキシシランとしては、モノメチルトリメトキシシラン、モノメチルトリエトキシシラン、モノエチルトリメトキシシラン、モノエチルトリエトキシシラン、モノメチルジメトキシモノエトキシシラン、モノエチルジメトキシモノエトキシシラン、好ましくはモノメチルトリメトキシシラン、モノメチルトリエトキシシランなどのモノ低級アルキルトリ低級アルコキシシランを挙げができる。完全加水分解縮合物に換算した場合、テトラアルコキシシラン5～75重量%、好ましくは10～70重量%、特に好ましくは15～70重量%およびアルキルトリアルコキシシラン25～95重量%、好ましくは30～90重量%、特に好ましくは30～85重量%の割合で使用する。なお、テトラアルコキシシランおよびアルキルトリアルコキシシランの合計は100重量%とする。また、本発明において完全加水分解縮合物とは、テトラアルコキシシランおよびアルカルトリアルコキシシランのアルコキシ基が100%加水分解してOH基とな

り、完全に縮合したものを示す。さらに本発明においてテトラアルコキシランが有するアルコキシル基の炭素数がアルキルトリアルコキシランが有するアルコキシル基の炭素数より大であることが好ましい。

【0006】本発明のシリカ系被膜形成用塗布液は、前記ポリアルコキシラン化合物の塩基性加水分解縮合生成物を、S i O₂換算濃度5～25重量%の割合で含有する有機溶剤溶液からなるものであって、以下に示す方法により、効率よく製造することができる。まず、テトラアルコキシランとアルキルモノアルコキシランとからなるポarialコキシラン化合物を第一有機溶剤に溶解して、S i O₂換算濃度1～5重量%の溶液を調製する。また、この際用いられる第一有機溶剤としては、ポarialコキシラン化合物、水および塩基性触媒と共に溶解することができ、しかも加水分解反応及びそれに続く脱水縮合反応に支障のないものであればよく、特に制限はない。このようなものとしては、例えばメタノール、エタノール、プロパノールなどの低級アルコール類や、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類や、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール又はそのモノメチルエーテル、モノエチルエーテル、モノプロピルエーテル、モノブチルエーテル、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、モノメチルエーテルアセテート、モノエチルエーテルアセテートなどの多価アルコール類及びその誘導体などが挙げられる。これらは単独で用いてもよいし、2種以上を混合して用いてもよい。これらの中でアルコール系溶剤が好適である。

【0007】次に、該ポarialコキシラン化合物を、塩基性触媒の存在下に加水分解縮合させる。本発明で使用することのできる塩基性触媒としては、アンモニア(アンモニア水溶液を含む)、有機アミン、アルカリ性無機化合物が挙げられるが、本発明においてはアンモニアおよび有機アミンが好ましい。本発明において有機アミンとしては、アルキルアミン、アルカノールアミン、アリールアミンなどを挙げることができる。本発明で使用することのできるアルキルアミンとしては、メチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、ヘキシルアミン、オクチルアミン、N, N-ジメチルアミン、N, N-ジエチルアミン、N, N-ジプロピルアミン、N, N-ジブチルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミンなどの炭素数1～4のアルキル基を有する化合物、メトキシメチルアミン、メトキシエチルアミン、メトキシプロピルアミン、メトキシブチルアミン、エトキシメチルアミン、エトキシエチルアミン、エトキシプロピルアミン、エトキシブチルアミン、プロポキシメチルアミン、プロポキシエチルアミン、プロポキシプロピルアミン、プロポキシブチルアミン、ブトキシメチルアミン、

ブトキシエチルアミン、ブトキシプロピルアミン、ブトキシブチルアミンなどのアルコキシ基を有する化合物などを挙げることができる。アルカノールアミンとしては、メタノールアミン、エタノールアミン、プロパノールアミン、ブタノールアミン、N-メチルメタノールアミン、N-エチルメタノールアミン、N-ブロピルメタノールアミン、N-ブチルメタノールアミン、N-メチルエタノールアミン、N-エチルエタノールアミン、N-ブロピルエタノールアミン、N-ブチルエタノールアミン、N-メチルブロパノールアミン、N-エチルブロパノールアミン、N-ブチルブロパノールアミン、N-メチルブタノールアミン、N-エチルブタノールアミン、N-ブロピルブタノールアミン、N-ブチルブタノールアミン、N, N-ジメチルメタノールアミン、N, N-ジエチルメタノールアミン、N, N-ジブロピルメタノールアミン、N, N-ジメチルエタノールアミン、N, N-ジエチルエタノールアミン、N, N-ジブチルエタノールアミン、N, N-ジメチルブロパノールアミン、N, N-ジエチルブロパノールアミン、N, N-ジブチルブロパノールアミン、N, N-ジメチルブタノールアミン、N, N-ジエチルブタノールアミン、N, N-ジブチルブタノールアミン、N-メチルジメタノールアミン、N-エチルジメタノールアミン、N-ブロピルジメタノールアミン、N-ブチルジメタノールアミン、N-メチルジエタノールアミン、N-エチルジエタノールアミン、N-ブロピルジエタノールアミン、N-ブチルジエタノールアミン、N-メチルジプロパノールアミン、N-エチルジプロパノールアミン、N-ブロピルジプロパノールアミン、N-ブチルジプロパノールアミン、N-メチルジブタノールアミン、N-エチルジブタノールアミン、N-ブロピルジブタノールアミン、N-ブチルジブタノールアミン、N-（アミノメチル）メタノールアミン、N-（アミノメチル）エタノールアミン、N-（アミノメチル）ブロパノールアミン、N-（アミノメチル）ブタノールアミン、N-（アミノエチル）メタノールアミン、N-（アミノエチル）エタノールアミン、N-（アミノエチル）ブロパノールアミン、N-（アミノエチル）ブタノールアミン、N-（アミノプロピル）メタノールアミン、N-（アミノプロピル）エタノールアミン、N-（アミノブチル）メタノールアミン、N-（アミノブチル）エタノールアミン、N-（アミノブチル）ブロパノールアミン、N-（アミノブチル）ブタノールアミンなどを挙げができる。またアリールアミンとしてはアニリン、N-メチルアニリンなどを挙げることができる。

【0008】さらに有機アミンとしてテトラメチルアンモニウムハイドロキサイド、テトラエチルアンモニウムハイドロキサイド、テトラプロピルアンモニウムハイドロキサイド、テトラブチルアンモニウムハイドロキサイド、テトラメチルエチレンジアミン、テトラエチルエチレンジアミン、テトラプロピルエチレンジアミン、テトラブチルエチレンジアミン、メチルアミノメチルアミン、メチルアミノエチルアミン、メチルアミノプロピルアミン、メチルアミノブチルアミン、エチルアミノメチルアミン、エチルアミノエチルアミン、エチルアミノブロピルアミン、エチルアミノブチルアミン、ブロピルアミノメチルアミン、ブロピルアミノエチルアミン、ブロピルアミノブチルアミン、ブチルアミノメチルアミン、ブチルアミノエチルアミン、ブチルアミノブロピルアミン、ブチルアミノブチルアミン、ビリジン、ピロール、ピペラジン、ピロリジン、ピペリジン、ピコリン、モルホリン、メチルモルホリン、ジアザビシクロオクラン、ジアザビシクロノナノ、ジアザビシクロウンデセンなど挙げることができる。

【0009】これらの塩基性触媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。本発明においてアルカリ性化合物としては、アルキルアミンを用いるとシリカ系膜の基板への密着性の点からより好ましい。本発明において、アルカリ性化合物の使用量はテトラアルコキシランおよびアルキルモノアルコキシランの合計1モルに対して0.00001モル以上であるが、特に好ましくは0.01モル以上、特に好ましくは0.1モル以上である。

【0010】加水分解縮合反応は、第一有機溶剤中において、前記シラン化合物を水及び上記塩基性触媒と接触させることにより行われる。この際の水の量は、用いるシラン化合物中のアルコキシル基の数に応じて変わるが、通常シラン化合物1モルに対し、2:0~20モル、好ましくは4.0~10モルの範囲で選ばれる。この加水分解縮合反応は、室温下で行ったのち、1日ないし2週間程度室温で熟成させるのが好ましい。

【0011】このようにして、加水分解及び脱水縮合反応させたのち、第二有機溶剤により溶剤置換して、SiO₂換算濃度の高い、すなわちSiO₂換算濃度5~25重量%の本発明のシリカ系被膜形成用塗布液を調製する。この際用いられる第二有機溶剤としては、アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、アミド系溶媒、エステル系溶媒および非プロトン系溶媒の群から選ばれた少なくとも1種が挙げられる。ここで、アルコール系溶媒としては、メタノール、エタノール、n-ブロパノール、i-ブロパノール、n-ブタノール、i-ブタノール、sec-ブタノール、t-ブタノール、n-ペントノール、i-ペントノール、2-メチルブタノール、sec-ペントノール、t-ペントノール、3-メトキシブタノール、t-ペントノール、3-メトキシブタノール、sec-ペントノール、t-ペントノール、3-メトキシブタノ

ル、n-ヘキサノール、2-メチルペントノール、sec-ヘキサノール、2-エチルブタノール、sec-ヘプタノール、n-オクタノール、2-エチルヘキサノール、sec-オクタノール、n-ノニルアルコール、2,6-ジメチルヘプタノール-4、n-デカノール、sec-ウンデシルアルコール、トリメチルノニルアルコール、sec-テトラデシルアルコール、sec-ヘプタデシルアルコール、フェノール、シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール、3,10,3,5-トリメチルシクロヘキサノール、ベンジルアルコール、ジアセトンアルコールなどのモノアルコール系溶媒；

【0012】エチレングリコール、1,2-プロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、ペンタンジオール-2,4,2-メチルペンタンジオール-2,4、ヘキサンジオール-2,5、ヘプタンジオール-2,4,2-エチルヘキサンジオール-1,3、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、トリプロピレングリコールなどの多価アルコール系溶媒；エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノヘキシルエーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチレングリコールモノ-2-エチルブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエーテルなどの多価アルコール部分エーテル系溶媒；などを挙げることができる。これらのアルコール系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0013】これらアルコールのうち、n-ブロパノール、i-ブロパノール、n-ブタノール、i-ブタノール、sec-ブタノール、t-ブタノール、n-ペントノール、i-ペントノール、2-メチルブタノール、sec-ペントノール、t-ペントノール、3-メトキシブタノール、n-ヘキサノール、2-メチルペントノール、sec-ヘキサノール、2-エチルブタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノブロピルエーテル、プロピレングリコールモノヘキシルエーテルなどが好ましい。

【0014】ケトン系溶媒としては、アセトン、メチル

エチルケトン、メチル-*n*-ブロピルケトン、メチル-*n*-ブチルケトン、ジエチルケトン、メチル-*i*-ブチルケトン、メチル-*n*-ベンチルケトン、エチル-*n*-ブチルケトン、メチル-*n*-ヘキシルケトン、ジ-*i*-ブチルケトン、トリメチルノナノン、シクロヘキサン、2-ヘキサン、メチルシクロヘキサン、2、4-ペントンジオン、アセトニルアセトン、アセトフェノン、フェンチョンなどのほか、アセチルアセトン、2、4-ヘキサンジオン、2、4-ヘプタンジオン、3、5-ヘプタンジオン、2、4-オクタンジオン、3、5-オクタンジオン、2、4-ノナンジオン、3、5-ノナンジオン、5-メチル-2、4-ヘキサンジオン、2、2、6、6-テトラメチル-3、5-ヘプタンジオン、1、1、1、5、5-ヘキサフルオロー-2、4-ヘプタンジオンなどの β -ジケトン類などが挙げられる。これらのケトン系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0015】アミド系溶媒としては、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、N、N-ジメチルホルムアミド、N-エチルホルムアミド、N、N-ジエチルホルムアミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N、N-ジメチルアセトアミド、N-エチルアセトアミド、N、N-ジエチルアセトアミド、N-メチルプロピオニアミド、N-メチルピロリドン、N-ホルミルモルホリン、N-ホルミルピペリジン、N-ホルミルピロリジン、N-アセチルモルホリン、N-アセチルピペリジン、N-アセチルピロリジンなどが挙げられる。これらのアミド系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0016】エステル系溶媒としては、ジエチルカーボネート、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジエチル、酢酸メチル、酢酸エチル、 γ -ブチロラクトン、 γ -バレロラクトン、酢酸-*n*-ブロピル、酢酸-*i*-ブロピル、酢酸-*n*-ブチル、酢酸-*i*-ブチル、酢酸-*s*-*e*-*c*-ブチル、酢酸-*n*-ペンチル、酢酸-*s*-*e*-*c*-ペンチル、酢酸-3-メトキシブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸-2-エチルブチル、酢酸-2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、酢酸シクロヘキシル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸-*n*-ノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢酸エチレンジリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレンジリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレンジリコールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレンジリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレンジリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレンジリコールモノメチルエーテル、ジ酢酸グリコール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エ

チル、プロピオン酸-*n*-ブチル、プロピオン酸-*i*-アミル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジ-*n*-ブチル、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸-*n*-ブチル、乳酸-*n*-アミル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチルなどが挙げられる。これらエステル系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。非プロトン系溶媒としては、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド、N、N、N'、N'-テトラエチルスルファミド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、N-メチルモルホロン、N-メチルピロール、N-エチルピロール、N-メチル- Δ 3-ピロリン、N-メチルピペリジン、N-エチルピペリジン、N、N-ジメチルピペラジン、N-メチルイミダゾール、N-メチル-4-ピペリドン、N-メチル-2-ピペリドン、N-メチル-2-ピロリドン、1、3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、1、3-ジメチルテトラヒドロ-2(1H)-ピリミジノンなどを挙げることができる。以上の有機溶媒は、1種あるいは2種以上を混合して使用することができる。本発明において、第二の有機溶剤としては多価アルコール部分

20 エーテル系溶媒および非プロトン系溶媒が好ましい。

【0017】このようにして調製された本発明のシリカ系被膜形成用塗布液を用い、シリカ系被膜を形成させるには、以下に示す方法を用いることができる。まず、本発明のシリカ系被膜形成用塗布液を基板上に塗布、乾燥して塗膜を形成する。この際用いる基板としては特に制限はなく、形成されるシリカ系被膜の用途に応じて適宜選択される。例えば層間絶縁膜とする場合は、シリコンウェーハ上にアルミニウムなどの金属配線層を有するものを、中間膜の場合は多層レジスト法における下層レジストを、平坦化膜とする場合はシリコンウェーハ上に金属配線層とその上にCVD法などによる層間絶縁膜を有するもの又はシリコンウェーハ上に多結晶シリコン層からなる配線層が設けられたものをそれぞれ用いることができる。

【0018】このような基板上に、該塗布液を塗布する方法としては、例えばスプレー法、スピンドル法、ディップコート法、ロールコート法など、任意の方法を用いることができるが、半導体素子製造には、通常スピンドル法が用いられる。

40 【0019】このようにして、比誘電率2.5以下程度の比誘電率の低いシリカ系被膜が形成される。この被膜の厚さは、該シリカ系被膜の用途などに応じて適宜選択されるが、一般的には0.2~1.0 μm 程度である。

【0020】

【実施例】次に、本発明を実施例により、さらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定されるものではない。

【0021】慣性半径
下記条件によるゲルパーキエーションクロマトグラフィー(GPC) (屈折率、粘度、光散乱測定) 法により測

定した。

試料溶液：シラン化合物の加水分解縮合物を、固体分濃度が0.25%となるように、10mMのLiBrを含むメタノールで希釈し、GPC（屈折率、粘度、光散乱測定）用試料溶液とした。

装置：東ソー（株）製、GPCシステム モデル GP C-8020

東ソー（株）製、カラム Alpha 5000/3000

ピスコテック社製、粘度検出器および光散乱検出器 モデル T-60 デュアルメーター

キャリア溶液：10mMのLiBrを含むメタノール

キャリア送液速度：1ml/min

カラム温度：40°C

比誘電率

得られた膜に対して蒸着法によりアルミニウム電極パターンを形成させ比誘電率測定用サンプルを作成した。該サンプルを周波数100kHzの周波数で、横河・ヒューレットパッカード（株）製、HP16451B電極およびHP4284AプレシジョンLCRメータを用いてCV法により当該塗膜の比誘電率を測定した。

弾性率（ヤング率）

得られた膜を、ナノインデンターXP（ナノインストルメント社製）を用いて、連続剛性測定法により測定した。

【0022】実施例1

40%メチルアミン水溶液27g、超純水228gおよびエタノール570gの混合溶液中に、メチルトリメトキシシラン13.6g（完全加水分解縮合物換算6.7g）とテトラエトキシシラン20.9g（完全加水分解縮合物6g）を加えて、60°Cで2時間反応させたのち、プロピレングリコールモノプロピルエーテル200gを加え、その後、減圧下で全溶液量116gとなるまで濃縮し、その後、酢酸の10%プロピレングリコールモノプロピルエーテル溶液10gを添加し、固体分含有量10%の組成物溶液を得た。得られた組成物溶液中の加水分解縮合物の慣性は12nmであった。

実施例2

実施例1においてメチルトリメトキシシランの使用量を22gに、テトラエトキシシランの使用量を9gとした以外は実施例1と同様にして固体分含有量10%の組成

物溶液を得た。得られた組成物溶液中の加水分解縮合物の慣性は12nmであった。

実施例3

実施例1においてメチルトリメトキシシランの使用量を10gに、テトラエトキシシランの使用量を28gとした以外は実施例1と同様にして固体分含有量10%の組成物溶液を得た。得られた組成物溶液中の加水分解縮合物の慣性は12nmであった。

膜の形成

10 上記実施例1～3で得られた組成物を、孔径0.02μmのフィルターで濾過した後、フィルターには残留物がなく、濾過が可能であった。濾過した8インチシリコンウェハ上にスピンドル法により塗布し、大気中80°Cで5分間、次いで窒素下200°Cで5分間加熱したのち、さらに真空中で340°C、360°C、380°Cの順でそれぞれ30分間ずつ加熱し、さらに真空中425°Cで1時間加熱し、無色透明のシリカ系膜を形成した。得られたシリカ系膜について前述の評価を行った。結果を表1に示す。

【0023】比較例1

実施例1においてメチルトリメトキシシランの使用量を14gとし、テトラエトキシシランの代わりにトリメトキシシラン15.7gを使用した以外は実施例1と同様にして固体分含有量10%の組成物溶液を得たところ、粒子が生成し溶液は白濁していた。

比較例2

実施例1においてメチルトリメトキシシランを使用せず、テトラエトキシシランの使用量を48gとした以外は実施例1と同様にして固体分含有量10%の組成物溶液を得たところ、粒子が生成し溶液は白濁していた。

比較例3

実施例1においてテトラエトキシシランを使用せず、メチルトリメトキシシランの使用量を25gとした以外は実施例1と同様にして固体分含有量10%の組成物溶液を得たところ、粒子が生成し溶液は白濁していた。

【0024】膜の形成

比較例1～3で得られた組成物を、孔径0.02μmのフィルターで濾過しようとしたところ、フィルターが詰まりし濾過不可能であった。

【0025】

【表1】

	実施例1	実施例2	実施例3
比誘電率	2.3	2.1	2.0
弾性率 (G/Pa)	5.5	4.0	6.5

【発明の効果】本発明によれば、半導体素子の製造において使用される平坦化膜や層間絶縁膜などとして有用な

比誘電率の低い、特に比誘電率2.5以下程度のシリカ系被膜形成用塗布液が効率よく得られる。

フロントページの続き

F ターム(参考) 4J002 CP031 DF007 DJ016 EN007
FD147 GQ05 HA01
4J035 AA01 BA11 EA01 EB02 EB03
LA03 LB01
4J038 DL021 DL031 KA06 NA21
PB09
5F058 AC03 AF04 AH02 BA20 BD04
BF46 BH04 BJ02